

【11】證書號數：M380559

【45】公告日：中華民國 99 (2010) 年 05 月 11 日

【51】Int. Cl. : *G11C11/16 (2006.01)*

新型

全 3 頁

【54】名稱：磁電異質結構

【21】申請案號：098218936

【22】申請日：中華民國 98 (2009) 年 10 月 14 日

【72】創作人：陳宏仁 (TW)；高銘政 (TW)；楊尚霖 (TW)

【71】申請人：修平技術學院

HSIUPING INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

臺中縣大里市工業路 11 號

【74】代理人：高玉駿；楊祺雄

[57]申請專利範圍

1. 一種磁電異質結構，包含：一基體；以及一磁電複合薄膜，係疊置於該基體上且由至少一鐵電層與至少一超巨磁阻鐵磁層直接交互疊合而成。
2. 依據申請專利範圍第 1 項所述之磁電異質結構，其中，每一鐵電層的厚度是介於 50~100nm 之間。
3. 依據申請專利範圍第 1 項所述之磁電異質結構，其中，每一超巨磁阻鐵磁層的厚度是介於 50~100nm 之間。
4. 依據申請專利範圍第 1 項所述之磁電異質結構，其中，該基體具有一基底層以及一疊置於該基底層上之擴散阻絕層。
5. 依據申請專利範圍第 4 項所述之磁電異質結構，其中，該基體還具有一疊置於該擴散阻絕層上之附著層以及一疊置於該附著層上之電極層。

圖式簡單說明

圖 1 是一示意圖，說明習知異質結構薄膜之組成結構；及圖 2 是一示意圖，說明本新型磁電異質結構之一較佳實施例。

(2)

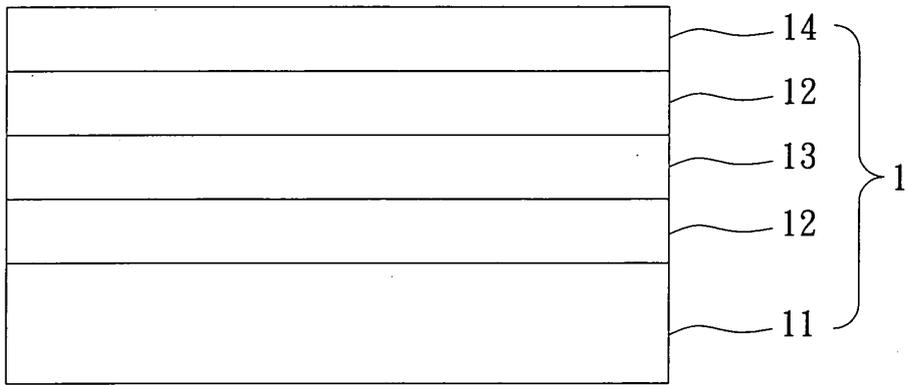


圖 1

(3)

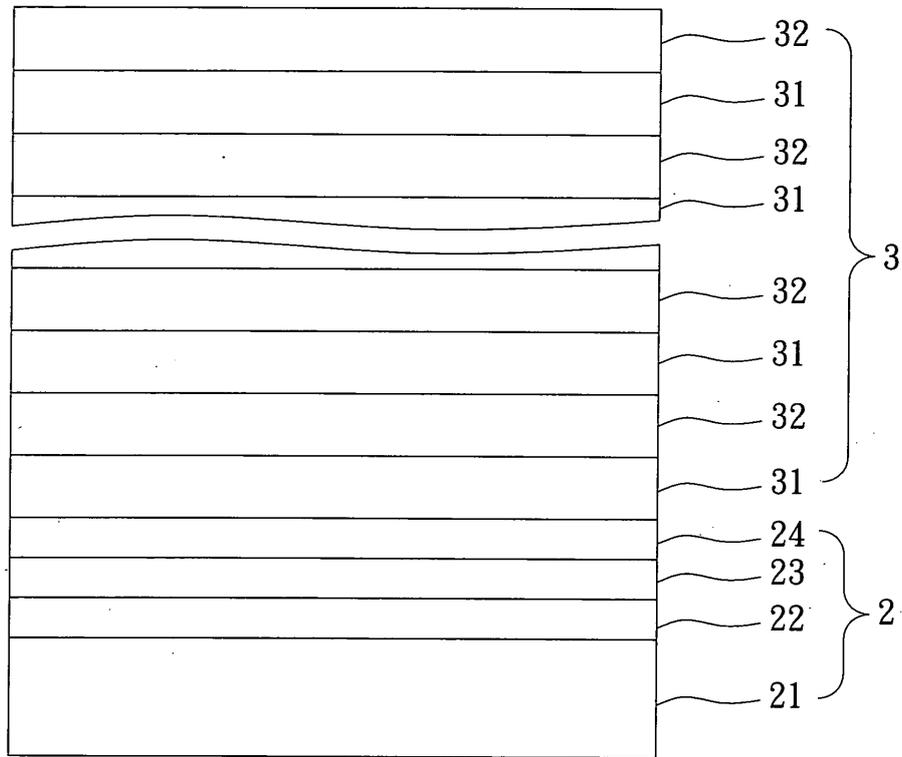


圖2

